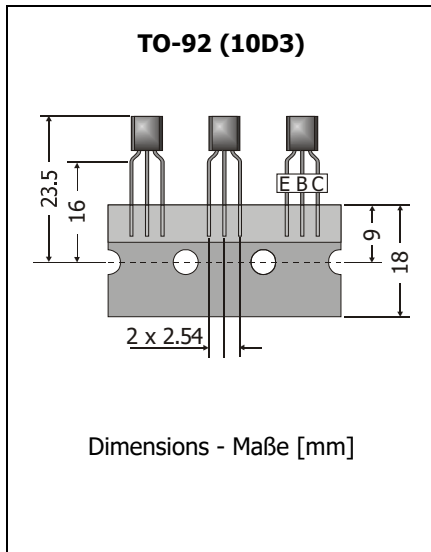


MPSA92 High Voltage PNP Transistors Hochspannungs-PNP-Transistoren	I_C = - 500 mA h_{FE1} > 40 T_{jmax} = 150°C	V_{CEO} = - 300 V P_{tot} = 625 mW
---	--	---

Version 2016-03-02



Typical Applications

Signal processing,
Switching, Amplification
Commercial grade ¹⁾

Features

High collector voltage
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾



Mechanical Data ¹⁾

Taped in ammo pack (Raster 2.54) 4000

Weight approx. 0.01 g

Case material UL 94V-0

Solder & assembly conditions 260°C/10s
MSL N/A

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
Schalten, Verstärken
Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Hohe Kollektorspannung
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet in Ammo-Pack (Raster 2.54)

Gewicht ca.

Gehäusematerial

Löt- und Einbaubedingungen

Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren	MPSA42
--	--------

Maximum ratings ²⁾

Grenzwerte ²⁾

Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V _{CEO}	300 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V _{CBO}	300 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- V _{EBO}	5 V
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	625 mW ³⁾
Collector current – Kollektorstrom	DC	- I _C	500 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _s	-55...+150°C

Characteristics

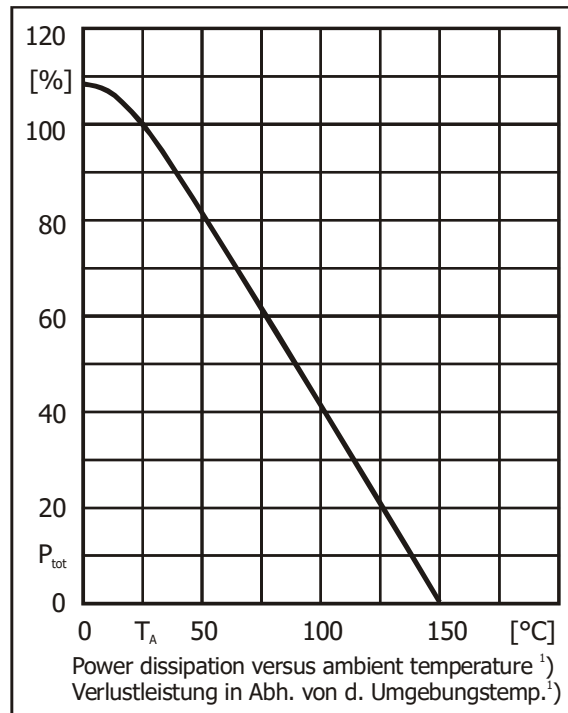
Kennwerte

	T _j = 25°C	Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom I _E = 0, V _{CB} = 200 V	- I _{CBO}	–	–	250 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom I _B = 0, V _{EB} = 3 V	- I _{EBO}	–	–	100 nA
Collector saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ⁴⁾ I _C = 20 mA, I _B = 2 mA	- V _{CEsat}	–	–	500 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ⁴⁾ I _C = 20 mA, I _B = 2 mA	- V _{BEsat}	–	–	0.9 V

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 T_A = 25°C, unless otherwise specified – T_A = 25°C, wenn nicht anders angegeben
- 3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
- 4 Tested with pulses tp = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen tp = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

Characteristics
Kennwerte

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾					
$V_{CE} = 10\text{ V}$	$I_C = 1\text{ mA}$	h_{FE}	25	–	–
	$I_C = 10\text{ mA}$		40	–	–
	$I_C = 30\text{ mA}$		25	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
$V_{CE} = 20\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$		f_T	–	70 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
$V_{CB} = 20\text{ V}, I_E = i_e = 0, f = 1\text{ MHz}$		C_{CB0}	–	–	7 pF
Thermal resistance junction – ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		R_{thA}	< 200 K/W ²⁾		



0

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses $t_p = 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\ \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden